	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN210	文件编号	XS-W-129
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	15-A2-08
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

W2XN210 硅 NPN 型晶体管主要用于音频功放电路等

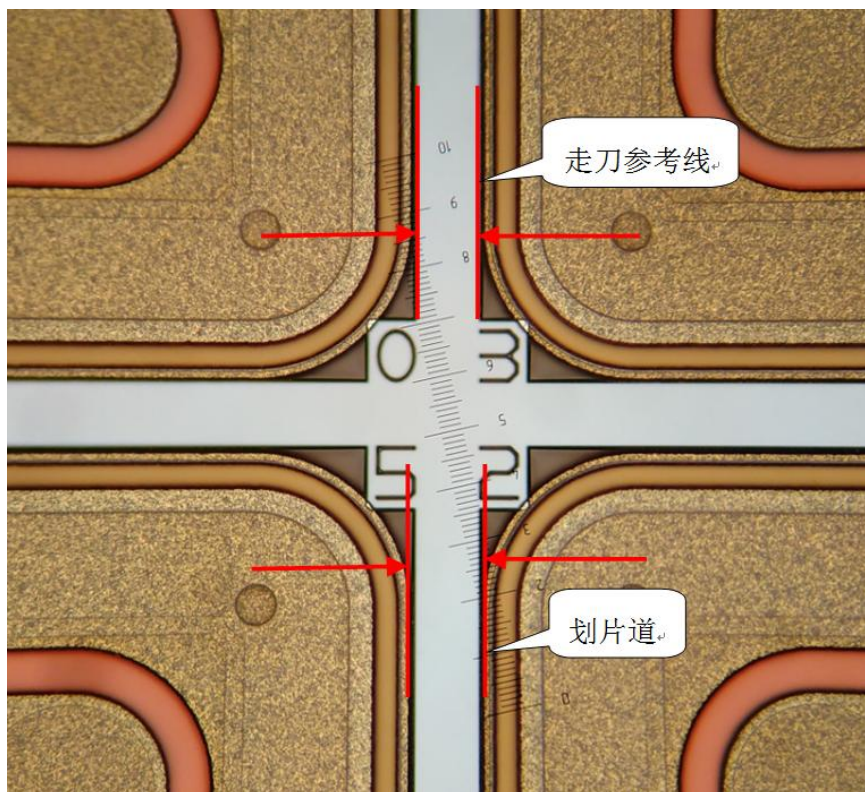
1.2 主要特点

- 大电流特性
- 饱和压降小

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	2.5×2.5		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	250±20		
	划片道* 尺寸 (μm)	54		
	键合区面积 (μm ²)	基区 (B)	408×976	
		发射区 (E)	454×764	
	钝化层	Si ₃ N ₄		
	正面电极	金属	铝	
		厚度 (μm)	5.0±0.5	
	背面电极金属	银		
	硅片直径 (mm)	φ125		
	装片要求 (推荐)	铅锡烧结		
键合要求 (推荐)	铝丝: Φ200μm; E、B 区各一根			

* 划片道位置示意图:




江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN210	文件编号	XS-W-129
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	15-A2-08
		页码	2/3

3 电特性 (在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

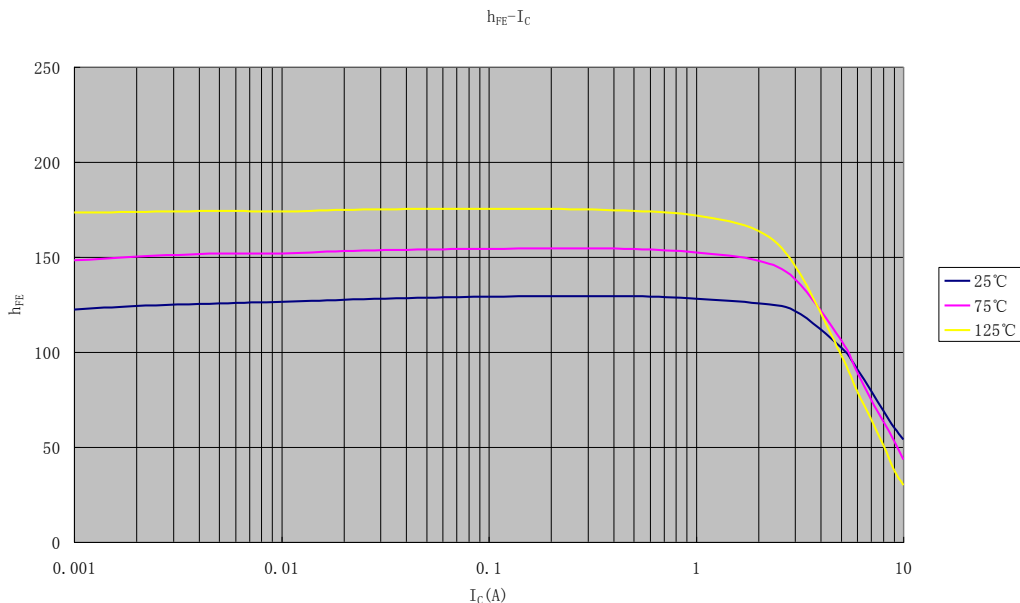
参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CBO}	130	V	推荐封装形式: T0-3P 推荐成品型号: 2SC5196 2SA1693
集电极-发射极电压	V_{CEO}	130	V	
发射极-基极电压	V_{EBO}	5	V	
集电极电流	I_C	8	A	
耗散功率 ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	60	W	
结温	T_J	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=120\text{V}, I_e=0$			10	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_c=0$			10	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_c=1\text{A}$	55		160	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_c=5\text{A}, I_B=500\text{mA}$			2.5	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_c=1\text{A}$ $f=1\text{MHZ}$	3			MHz

3.3 典型特性曲线



江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532



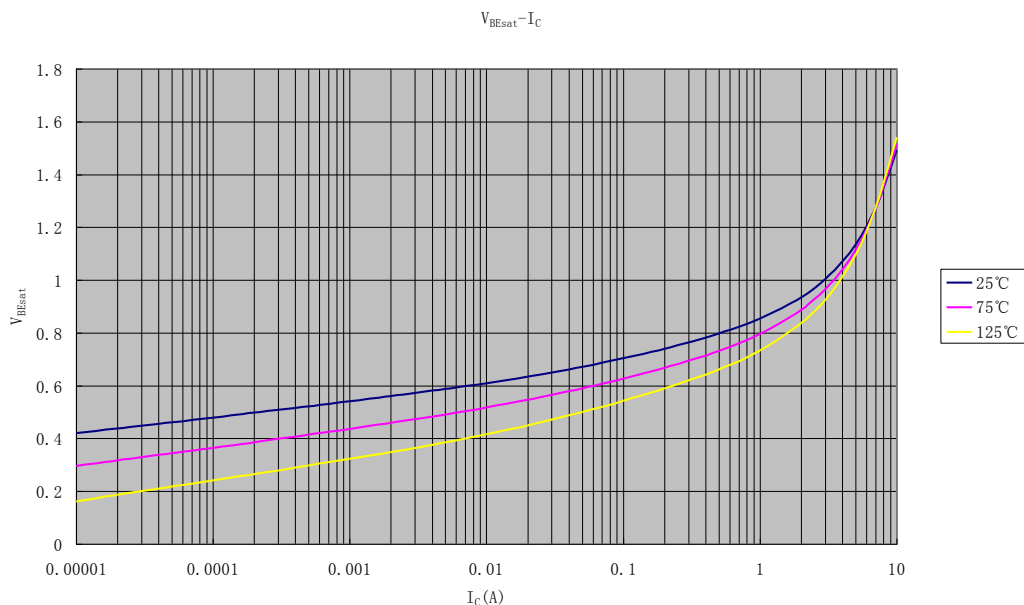
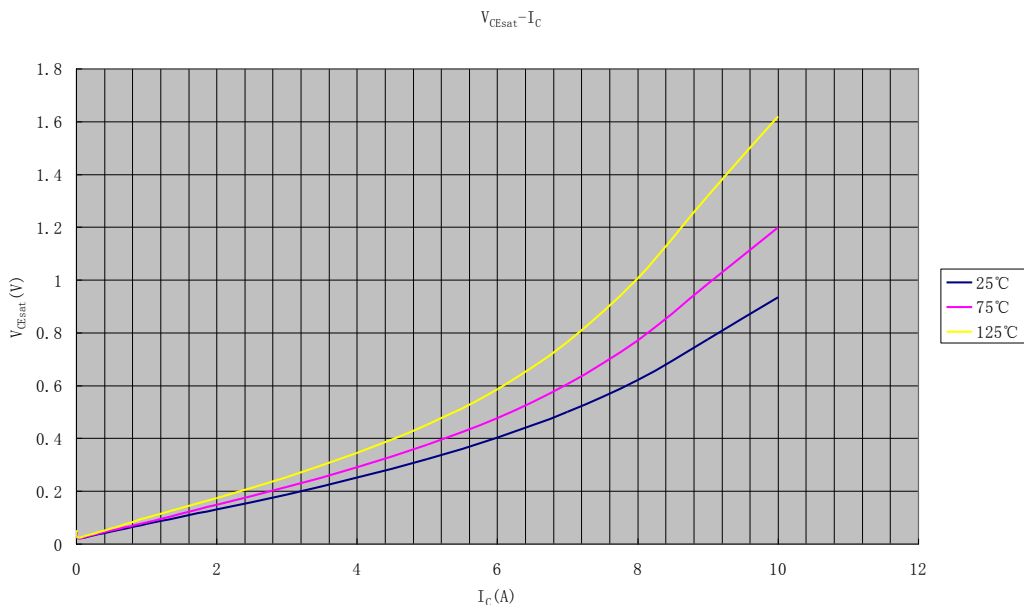
江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W2XN210

高频放大环境额定双极型晶体管

文件编号 XS-W-129

版本号 15-A2-08

页码 3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；

任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：<http://www.xs-elec.com>

电话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532